

Podsumowanie decyzji Komisji

z dnia 19 maja 2010 r.

dotyczącej postępowania na mocy art. 101 TFUE ⁽¹⁾ oraz art. 53 Porozumienia EOG

(Sprawa COMP/38.511 – DRAM)

(notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3152 wersja ostateczna)

(Jedynie teksty w języku angielskim, niemieckim i francuskim są autentyczne)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2011/C 180/09)

W dniu 19 maja 2010 r. Komisja przyjęła decyzję dotyczącą postępowania na mocy art. 101 TFUE i art. 53 Porozumienia EOG. Zgodnie z art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 ⁽²⁾ Komisja publikuje niniejszym nazwy stron i główną treść decyzji, w tym wszelkie nałożone kary, z uwzględnieniem uzasadnionego interesu przedsiębiorstw dotyczącego ochrony ich tajemnic handlowych. Wersja decyzji niezawierająca elementów poufnych jest dostępna w witrynie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji pod adresem:

<http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/>

WSTĘP

- (1) Decyzja jest adresowana do 10 przedsiębiorstw i dotyczy jednego ciągłego naruszenia art. 101 TFUE i art. 53 Porozumienia EOG.

1. OPIS SPRAWY

1.1. Procedura

- (2) Postępowanie wszczęto na podstawie wniosku o zwolnienie z grzywny złożonego dnia 29 sierpnia 2002 r. przez spółkę Micron. Spółka uzyskała warunkowe zwolnienie z sankcji w grudniu 2002 r. W okresie od grudnia 2003 r. do lutego 2006 r. spółki Infineon, Hynix, Samsung, Elpida i NEC zwróciły się do Komisji o złagodzenie kary. Pierwszy wniosek o udzielenie informacji został wysłany w marcu 2003 r., a na późniejszych etapach został wysłany szereg wniosków o udzielenie informacji.
- (3) Procedura ugodowa umożliwia Komisji zawieranie porozumień ugodowych w trybie uproszczonym. Została ona wprowadzona w czerwcu 2008 r. ⁽³⁾. Rozmowy ugodowe

w omawianej sprawie toczyły się od marca 2009 r. po tym, jak spółki zawiadomiły, że są przygotowane do podjęcia takich rozmów. Następnie, w grudniu 2009 r., wszystkie spółki złożyły oficjalne propozycje ugodowe, w których wprost i jednoznacznie potwierdziły swoją odpowiedzialność za naruszenie przepisów. W dniu 8 lutego tego roku spółki otrzymały pisemne zgłoszenie zastrzeżeń odpowiadające ich propozycjom i potwierdziły, że jego treść jest zgodna z ich propozycjami oraz że nadal są zainteresowane postępowaniem ugodowym. Komitet Doradczy ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydał pozytywną opinię w dniu 7 maja 2010 r. i Komisja przyjęła decyzję dnia 19 maja 2010 r.

1.2. Podsumowanie naruszenia przepisów

- (4) Decyzja dotyczy jednego ciągłego naruszenia art. 101 TFUE i art. 53 Porozumienia EOG na terytorium EOG. Strony naruszające stworzyły system lub sieć kontaktów i tajnej wymiany informacji, za pomocą której koordynowały ustalanie ogólnych poziomów cen i kwotowań dla głównych producentów oryginalnego sprzętu („OEM” – Original Equipment Manufacturers) – komputerów typu PC i serwerów, co ostatecznie prowadziło do zмовy cenowej wobec tych klientów. Działania te zmierzały do ograniczenia konkurencji w odniesieniu do głównych producentów komputerów PC i serwerów, jeśli chodzi o sprzedaż modułów dynamicznych pamięci o swobodnym dostępie („DRAM” – Dynamic Random Access Memory) (wszystkie przedsiębiorstwa), a także w celu sprzedaży pamięci Rambus-DRAM (tylko Toshiba, Samsung i Elpida), od dnia 1 lipca 1998 r. do dnia 15 czerwca 2002 r. w odniesieniu do pamięci DRAM i od dnia 9 kwietnia 2001 r. do dnia 15 czerwca 2002 r. w odniesieniu do pamięci Rambus-DRAM.

1.3. Adresaci i okres trwania naruszenia przepisów

- (5) Poniższe przedsiębiorstwa naruszyły art. 101 TFUE i art. 53 Porozumienia EOG przez to, że uczestniczyły

⁽¹⁾ Ze skutkiem od dnia 1 grudnia 2009 r. art. 81 i 82 Traktatu WE stały się, odpowiednio, art. 101 i 102 TFUE. Treść tych dwóch grup przepisów jest zasadniczo taka sama. Dla potrzeb niniejszej decyzji odniesienia do art. 81 i 82 Traktatu WE należy obecnie rozumieć jako odniesienia do art. 101 i 102 TFUE.

⁽²⁾ Dz.U. L 1 z 4.1.2003, s. 1. Rozporządzenie ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem (WE) nr 411/2004 (Dz.U. L 68 z 6.3.2004, s. 1). Ze skutkiem od dnia 1 grudnia 2009 r. art. 81 i 82 Traktatu WE stały się, odpowiednio, art. 101 i 102 TFUE. Treść tych dwóch grup przepisów jest zasadniczo taka sama. Dla potrzeb niniejszej decyzji odniesienia do art. 81 i 82 Traktatu WE należy obecnie rozumieć jako odniesienia do art. 101 i 102 TFUE.

⁽³⁾ Rozporządzenie Komisji (WE) nr 622/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 773/2004 w odniesieniu do prowadzenia postępowań ugodowych w sprawach kartelowych (Dz.U. L 171 z 1.7.2008, s. 3) i obwieszczenie Komisji o prowadzeniu postępowań ugodowych wobec przyjęcia decyzji na mocy art. 7 i art. 23 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1/2003 w sprawach kartelowych (Dz.U. C 167 z 2.7.2008, s. 1–6).

w podanych niżej okresach w praktykach sprzecznych z zasadami konkurencji, polegających na zniżce cenowej wobec głównych producentów OEM komputerów typu PC i serwerów w odniesieniu, odpowiednio, do pamięci DRAM i Rambus-DRAM:

- a) Micron Technology, Inc. od dnia 1 lipca 1998 r. do dnia 15 czerwca 2002 r.;
- b) Micron Europe Limited od dnia 1 lipca 1998 r. do dnia 15 czerwca 2002 r.;
- c) Micron Semiconductor (Deutschland) GmbH od dnia 1 lipca 1998 r. do dnia 15 czerwca 2002 r.;
- d) Infineon Technologies AG od dnia 14 listopada 1998 r. do dnia 15 czerwca 2002 r.;
- e) Hynix Semiconductor Inc. od dnia 1 lipca 1998 r. do dnia 15 czerwca 2002 r.;
- f) Hynix Semiconductor Europe Holding Ltd. od dnia 1 lipca 1998 r. do dnia 15 czerwca 2002 r.;
- g) Hynix Semiconductor Deutschland GmbH od dnia 1 lipca 1998 r. do dnia 15 czerwca 2002 r.;
- h) Hynix Semiconductor United Kingdom, Ltd. od dnia 1 lipca 1998 r. do dnia 15 czerwca 2002 r.;
- i) Samsung Electronics Co. Ltd. od dnia 1 lipca 1998 r. do dnia 15 czerwca 2002 r. w odniesieniu do pamięci DRAM (oraz od dnia 9 kwietnia 2001 r. do dnia 15 czerwca 2002 r. w odniesieniu do pamięci Rambus-DRAM);
- j) Samsung Semiconductor Europe GmbH od dnia 1 lipca 1998 r. do dnia 15 czerwca 2002 r. w odniesieniu do pamięci DRAM (oraz od dnia 9 kwietnia 2001 r. do dnia 15 czerwca 2002 r. w odniesieniu do pamięci Rambus-DRAM);
- k) Samsung Semiconductor Europe Ltd. od dnia 1 lipca 1998 r. do dnia 15 czerwca 2002 r. w odniesieniu do pamięci DRAM (oraz od dnia 9 kwietnia 2001 r. do dnia 15 czerwca 2002 r. w odniesieniu do pamięci Rambus-DRAM);
- l) Samsung Semiconductor France Sarl od dnia 1 lipca 1998 r. do dnia 15 czerwca 2002 r. w odniesieniu do pamięci DRAM (oraz od dnia 9 kwietnia 2001 r. do dnia 15 czerwca 2002 r. w odniesieniu do pamięci Rambus-DRAM);
- m) NEC Corporation od 1 lipca 1998 r. do dnia 28 lutego 2001 r. oraz pośrednio poprzez spółkę Elpida od dnia 1 marca 2001 r. do dnia 15 czerwca 2002 r.;
- n) Renesas Electronics Europe GmbH (wcześniej NEC Electronics (Europe) GmbH do dnia 1 kwietnia 2010 r.) od dnia 1 lipca 1998 r. do dnia 28 lutego 2001 r.;
- o) NEC Electronics (UK) Ltd. od dnia 1 lipca 1998 r. do dnia 28 lutego 2001 r.;
- p) Hitachi Ltd. od dnia 9 listopada 1998 r. do dnia 28 lutego 2001 r. oraz pośrednio poprzez spółkę Elpida od dnia 1 marca 2001 r. do dnia 15 czerwca 2002 r.;
- q) Hitachi Europe Ltd. od dnia 9 listopada 1998 r. do dnia 28 lutego 2001 r.;
- r) Mitsubishi Electric Corp. od dnia 24 listopada 1998 r. do dnia 15 czerwca 2002 r.;
- s) Mitsubishi Electric Europe BV od dnia 24 listopada 1998 r. do dnia 15 czerwca 2002 r.;
- t) Toshiba Corp. od dnia 1 lipca 1998 r. do dnia 22 kwietnia 2002 r. w odniesieniu do pamięci DRAM (oraz od dnia 9 kwietnia 2001 r. do dnia 22 kwietnia 2002 r. w odniesieniu do pamięci Rambus-DRAM);
- u) Toshiba Electronics Europe GmbH od dnia 1 lipca 1998 r. do dnia 22 kwietnia 2002 r. w odniesieniu do pamięci DRAM (oraz od dnia 9 kwietnia 2001 r. do dnia 22 kwietnia 2002 r. w odniesieniu do pamięci Rambus-DRAM);
- v) Elpida Memory Inc. od dnia 1 marca 2001 r. do dnia 15 czerwca 2002 r. w odniesieniu do pamięci DRAM (oraz od dnia 9 kwietnia 2001 r. do dnia 15 czerwca 2002 r. w odniesieniu do pamięci Rambus-DRAM);
- w) Elpida Memory (Europe) GmbH od dnia 1 marca 2001 r. do dnia 15 czerwca 2002 r. w odniesieniu do pamięci DRAM (oraz od dnia 9 kwietnia 2001 r. do dnia 15 czerwca 2002 r. w odniesieniu do pamięci Rambus-DRAM);
- x) Nanya Technology Corp. od dnia 12 października 2001 r. do dnia 15 czerwca 2002 r.

1.4. Środki zaradcze

- (6) W decyzji zastosowano się do wytycznych w sprawie grzywien z 2006 r. ⁽¹⁾. Decyzja nakłada grzywny na wszystkie spółki wymienione wyżej, w punkcie 1.3, z wyjątkiem Micron Technology, Inc., Micron Europe Limited i Micron Semiconductor (Deutschland) GmbH. Niemniej jednak, przy ustalaniu grzywiny, jaka ma być nałożona na firmę Samsung, o której mowa w motywie (13) poniżej, w decyzji nie uwzględniono sprzedaży pamięci Rambus-DRAM przez Samsung.

1.4.1. Podstawowa wysokość grzywiny

- (7) Podstawową wysokość grzywiny ustalono na 16 % przychodów przedsiębiorstwa ze sprzedaży pamięci DRAM (w tym pamięci Rambus-DRAM tam, gdzie ma to zastosowanie) ⁽²⁾ na rzecz głównych producentów OEM komputerów typu PC i serwerów na terytorium EOG.

⁽¹⁾ Dz.U. C 210 z 1.9.2006, s. 2.

⁽²⁾ W celu obliczenia grzywiny, która ma być nałożona na firmy Micron, Hynix, Infineon, Mitsubishi i Nanya, wzięto pod uwagę tylko wielkość przychodów ze sprzedaży pamięci DRAM, z wyłączeniem ewentualnej sprzedaży pamięci Rambus-DRAM. Jak już wspomniano, przy obliczaniu grzywiny dla firmy Samsung nie wzięto ponadto pod uwagę sprzedaży pamięci Rambus-DRAM przez tę firmę.

(8) Kwotę podstawową mnoży się przez liczbę lat uczestniczenia w naruszeniu przepisów, aby w pełni uwzględnić czas, przez jaki każde z przedsiębiorstw uczestniczyło we wspomnianym naruszeniu.

1.4.2. Korekty kwoty podstawowej

1.4.2.1. Okoliczności obciążające

(9) W tej sprawie nie występują okoliczności obciążające.

1.4.2.2. Okoliczności łagodzące

(10) W związku z okolicznościami łagodzącymi, wobec trzech (spośród dziesięciu) przedsiębiorstw grzywny zostały zmniejszone. Firmie Hynix przyznano obniżenie grzywny o 5 % w związku z bardzo szczególnymi okolicznościami, w jakich znalazła się w 2001 r.⁽¹⁾ Toshiba i Mitsubishi uzyskały obniżkę po 10 %, ponieważ zaangażowanie obu firm w odnośnym okresie było znacznie mniejsze niż innych dostawców.

1.4.2.3. Szczególna podwyżka w celach odstraszających

(11) Właściwe jest zastosowanie mnożnika do wymierzonych grzywien w oparciu o wielkość zaangażowanych przedsiębiorstw. Tak więc grzywna dla Hitachi zostaje pomnożona przez 1,2, natomiast grzywna dla firm Samsung i Toshiba zostaje pomnożona przez 1,1.

1.4.3. Zastosowanie 10 % limitu obrotów

(12) W tej sprawie nie wymaga się korygowania kwot w związku z obrotami przedsiębiorstw.

1.4.4. Zastosowanie obwieszczenia w sprawie łagodzenia kar z 2002 r.

(13) Firma Micron uzyskała zwolnienie z grzywien, firma Infineon uzyskała obniżenie grzywny o 45 %, firma Hynix uzyskała obniżenie grzywny o 27 %, a firmy Samsung, Elpida i NEC uzyskały obniżki grzywny po 18 %. Ponadto firmie Samsung przyznano *de facto* zwolnienie z grzywien w odniesieniu do pamięci Rambus-DRAM, oprócz obniżki w ramach złagodzenia grzywien w odniesieniu do pamięci DRAM.

2. GRZYWNY WYMIERZONE NA MOCY DECYZJI

(14) W odniesieniu do jednego ciągłego naruszenia przepisów rozpatrywanego w niniejszej decyzji wymierzono następujące grzywny:

a) dla Micron Technology Inc., Micron Europe Limited i Micron Semiconductor (Deutschland) GmbH, solidarnie: 0 EUR;

b) dla Infineon Technology AG: 56 700 000 EUR;

c) dla Hynix Semiconductor Inc., Hynix Semiconductor Europe Holding Ltd., Hynix Semiconductor Deutschland GmbH i Hynix Semiconductor United Kingdom, Ltd., solidarnie: 51 471 000 EUR;

d) dla Samsung Electronics Co. Ltd., Samsung Semiconductor Europe GmbH, Samsung Semiconductor Europe Ltd. i Samsung Semiconductor France Sarl, solidarnie: 145 728 000 EUR;

e) dla NEC Corporation, Renesas Electronics Europe GmbH (wcześniej NEC Electronics (Europe) GmbH do dnia 1 kwietnia 2010 r.) i NEC Electronics (UK) Ltd., solidarnie: 10 296 000 EUR;

f) dla Hitachi Ltd. i Hitachi Europe Ltd., solidarnie: 20 412 000 EUR;

g) dla Mitsubishi Electric Corp. i Mitsubishi Electric Europe BV, solidarnie: 16 605 000 EUR;

h) dla Toshiba Corp. i Toshiba Electronics Europe GmbH, solidarnie: 17 641 800 EUR;

i) dla Elpida Memory, Inc. i Elpida Memory (Europe) GmbH, NEC Corporation i Hitachi Ltd., solidarnie: 8 496 000 EUR;

j) dla Nanya Technology Corp.: 1 800 000 EUR; oraz

k) dla NEC Corporation i Hitachi Ltd., solidarnie: 2 124 000 EUR.

⁽¹⁾ Jak ustalono we wcześniejszym postępowaniu Komisji w sprawie antysubsydyjnej w UE, patrz rozporządzenie Komisji (WE) nr 708/2003 z dnia 23 kwietnia 2003 r., par. 148 i nast., potwierdzone przez rozporządzenie Komisji (WE) nr 1408/2003 z dnia 11 sierpnia 2003 r.